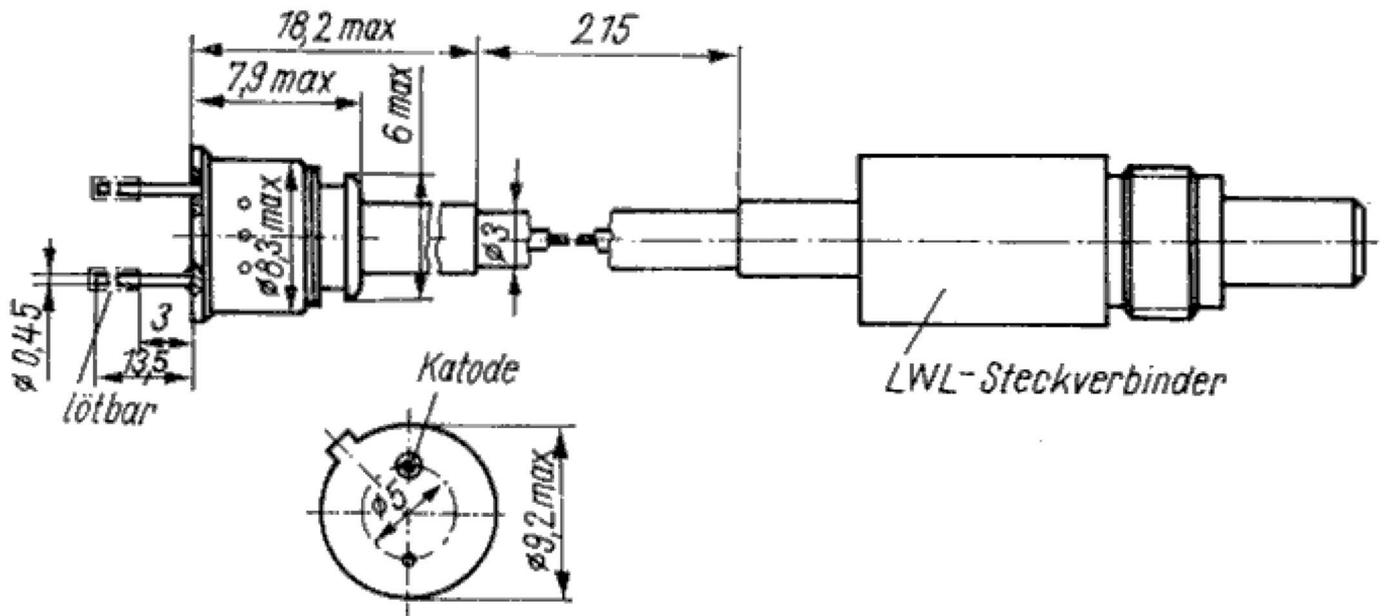


SP 109

Si-pin-Fotodiode insbesondere für den Einsatz in der Lichtleiter-nachrichtenübertragung (Teilnehmeranschlußbereich)



Grenzwerte

Gesamtverlustleistung

bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

$P_{\text{tot}} \leq 100 \text{ mW}$

Betriebstemperatur

$\vartheta_a -15 \dots +55^\circ\text{C}$

Lagerungstemperatur

$\vartheta_{\text{stg}} +5 \dots +35^\circ\text{C}$

(für 1 Monat)

$\vartheta_{\text{stg}} -40 \dots +55^\circ\text{C}$

Kennwerte bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

Dunkelstrom

bei $U_R = 20 \text{ V}$

$E_e = 0 \text{ lx}$

I_{RO}

min.

max.

2 nA

Spektrale

Empfindlichkeit

bei $\lambda = 850 \text{ nm}$

$U_R = 20 \text{ V}$

S_λ

0,3

AW^{-1}

Anstiegszeit

bei $U_R = 20 \text{ V}$

$R_L = 50 \text{ Ohm}$

t_r

2 ns

Gesamtkapazität

bei $f = 1 \text{ MHz}$

C_{tot}

2 pF